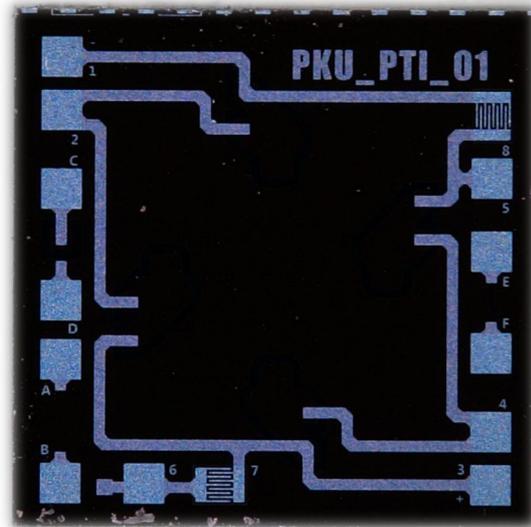


## PKU\_PTI\_01-G 型压力传感器芯片

### 产品概述

PKU\_PTI 系列传感器芯片基于单晶硅材料，基于单晶硅压阻效应，采用标准加工工艺制作的硅压阻式表面压力传感器芯片，具有精度高、工作温度宽、抗玷污强、长期稳定性好及安装应力影响小等特点，产品可工作于 $-55^{\circ}\text{C}\sim 150^{\circ}\text{C}$ 的温度范围。该芯片依靠公司自主研发技术，能够满足高精度、高可靠的工业级高端压力传感器及智能产品需要，能为客户提供最优质的解决方案。



### 应用

- 航空、航天、航海
- 工业过程控制
- 医疗器械
- 气象监控
- 汽车领域

### 产品特点

- 表压压阻式 MEMS 传感器芯片
- 大厚度芯片，隔绝应力：  
2.60 mm (L) × 2.60 mm (W) × 1.90mm (H)
- 电压源供电
- 开/闭惠斯通电桥，毫伏级输出
- 额定压力量程：0-200kPa
- 出众的长期稳定性，年稳定性优于 0.05%  
(需符合封装要求)

## 主要参数

参数	最小值	典型值	最大值	单位
满量程输出	80	100	120	mv@5V
电桥电阻	3.5	3.8	4	K $\Omega$
零点输出	-10	-	10	mV
热零点漂移		<0.04		%F. S. S. /K
电桥电阻温度系数	0.1	0.12	0.15	%/K
热灵敏度漂移	-0.2	-0.18	-0.16	%F. S. S. /K
迟滞	-	<0.05	-	$\pm$ %F. S. S.
长期稳定性	-	<0.05	-	$\pm$ %F. S. S. /year
线性误差	-	0.4	-	$\pm$ %F. S. S.
工作温度	-50	-	150	$^{\circ}$ C
工作电压	3	5	10	V

⊕：性能指标供参考，以实际订单为准。



# PKU\_PTI\_01

## 引脚定义

- 1 : GND
- 2 : VoutA
- 3 : VDD
- 4 : VoutB
- 5 : GND

